

# CANON ANELVA 产品

## 电子器件制造设备

### SAW滤波器用 溅射设备

#### EC7400 PVD

EC7400是用于形成SAW滤波器电极层的金属膜沉积的溅射设备。

#### ■ 特征

- Cluster(C to C) 配置。  
最大三个工艺腔
- 对应多种尺寸的晶圆。  
4inch\*5pcs, 6inch\*4pcs
- 斜角和晶圆旋转溅射。
- 优异的薄膜均匀性和再现性。



### 晶圆键合用 设备

#### BC7000 Series Bonding

BC7000系列是利用超高真空和薄膜沉积技术形成各种晶圆键合的原子扩散键合设备。

#### ■ 特征

- 室温下键合。
- 键合过程中无需加压。
- 高键合强度。
- 可键合任何类似或不同材料的晶圆。
- 高产量。



### SAW滤波器用 溅射设备

#### EC7430 PVD

EC7430是用于形成TC-SAW滤波器钝化层SiO<sub>2</sub>膜的溅射设备。

#### ■ 特征

- Cluster(C to C) 配置。  
最大三个工艺腔
- 双阴极+独特的等离子体控制溅射
- 高Aspect Ratio和均匀沉积。
- 高沉积速率且表面高平坦度。



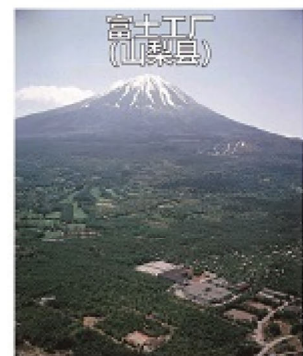
### Carbon Capping用 溅射设备

#### EC7400 Series PVD

EC7400系列是用于形成SiC器件碳覆盖的溅射设备。

#### ■ 特征

- 良好的膜厚均匀性。
- 膜特性变化小。
- 不影响注入的SiC层结晶。溅射的碳不因退化而变化。
- 高产量。



CANON ANELVA CORPORATION

<https://anelva.canon/en/>



# CANON ANELVA 产品

CANON ANELVA 自1967年成立以来，利用真空技术和真空薄膜沉积技术开发，制造，销售和服务于半导体，存储，电子器件和真空元件的制造设备。

2005年，我们成为佳能集团旗下公司。今天，我们的目标是以全球集团网络的优势来发展我们的业务，更好的服务于业界客户。

## 半导体器件制造设备

### ReRAM 存储器用 溅射设备

#### NC7940 PVD

NC7940溅射设备，用于形成特殊的氧化膜，这是下一代非易失性存储器ReRAM的核心元素。

#### ■ 特征

- > 超高真空和斜角溅射。
- > 优异的薄膜沉积均匀性。
- > ALD同等的氧化膜溅射成膜。
- > 根据不同的Rs要求，控制薄膜中的氧元素含量



### Logic HKMG用 溅射设备

#### FC7100 PVD

FC7100是用于形成超薄膜的溅射设备，超薄膜是HKMG(Gate First)工艺的核心元素。

#### ■ 特征

- > 通过超高真空和斜角共溅射控制超薄膜组织成分。
- > 高精度控制(0.1 nm单位)超薄膜厚度和优异性的均匀 ( $1\sigma < 1\%$ )。
- > 采用小型阴极，材料成本低。轻松切换材料。



### 磁传感器用 溅射设备

#### NC7900 PVD

NC7900是一种利用隧道磁阻效应的TMR传感器溅射设备。

#### ■ 特征

- > 提供 $\pm 1\%$ 或更少的优良的薄膜厚度分布。
- > 低压沉积工艺使金属薄膜表面平整，电阻率低。
- > 超高真空度下成膜，提供高MR比。
- > 广泛的沉积模块阵容。(多阴极的配置)



### 连线用 溅射设备

#### IC7500 PVD

IC7500是形成金属连线材料的溅射设备，主要用于半导体存储器。我们独创的CAELA 阴极在反应溅射和高应力材料上具有优异的均匀性。

#### ■ 特征

- > 阴极磁体位置(3D)在每个工艺程序中都是可变的。(易于优化均匀性)
- > 在半导体存储器生产线中提供>90%的稼动率。(故障率< 1%)

